



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2016106692, 25.02.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.02.2016

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 25.02.2016

(43) Дата публикации заявки: 30.08.2017 Бюл. № 25

(45) Опубликовано: 15.09.2017 Бюл. № 26

Адрес для переписки:

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ,
Информационно-патентный отдел, Бабенко О.И.

(72) Автор(ы):

Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Букашкина Татьяна Леонидовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный
технический университет" (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2565361 C1, 20.10.2015. RU
2548049 C1, 10.04.2015. RU 2526225 C1,
20.08.2014. RU 2422811 C1, 27.06.2011.

(54) Полупроводниковый анализатор оксида углерода

(57) Формула изобретения

Полупроводниковый газовый датчик, содержащий полупроводниковое основание и подложку, отличающийся тем, что полупроводниковое основание выполнено из поликристаллической пленки твердого раствора на основе CdSe и CdTe состава $(\text{CdSe})_{0,85}(\text{CdTe})_{0,15}$, а подложкой служит электродная площадка пьезокварцевого резонатора.

RU
2 6 3 1 0 1 0
C 2